
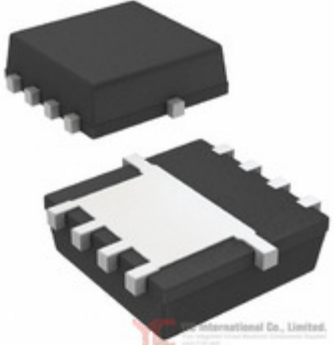



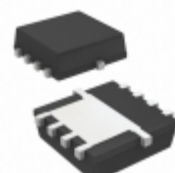
	<p>SISA10DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SISA10DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SISA10DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 250 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISA10DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	250 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.7 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.6W (Ta), 39W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SISA10DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2425pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	51nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 30A (Tc) 3.6W (Ta), 39W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SISA10DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA10DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA10DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SISA10DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISA10DN-T1 VISHAY SISA10DN-T1 VISHAY</p>	 <p>SISA12JN-T1-GE3 VISHAY SISA12JN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SISA04DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p>	 <p>SISA10DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A 1212-8</p>
 <p>SISA12ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 25A 1212-8</p>	 <p>SISA10DN vishay SISA10DN vishay</p>	 <p>SISA12ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 25A 1212-8</p>	 <p>SISA01DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V POWERPAK 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISA10DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISA10DN-T1-GE3 Datenblatt	SISA10DN-T1-GE3-Datenblätter	SISA10DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISA10DN-T1-GE3
SISA10DN-T1-GE3 Electronic	SISA10DN-T1-GE3-Komponenten	SISA10DN-T1-GE3-Verteiler	SISA10DN-T1-GE3-Bild	SISA10DN-T1-GE3-Teil
SISA10DN-T1-GE3 Preis	SISA10DN-T1-GE3 Hersteller	SISA10DN-T1-GE3 Bild	SISA10DN-T1-GE3 Aktie	SISA10DN-T1-GE3 Inventar
SISA10DN-T1-GE3 Neu	SISA10DN-T1-GE3 Original	SISA10DN-T1-GE3 garantiert	SISA10DN-T1-GE3 RFQ	SISA10DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited